

2025 台積電博士獎學金申請辦法(第一梯次)

一、關於台積電博士獎學金

為帶動台灣整體半導體產業之關鍵人才質量及研發能量，持續推動先進技術之發展，台積電設立此獎學金鼓勵優秀學生投入半導體相關領域攻讀博士學位，並與學校教授共同打造頂尖的產學合作環境。

二、獎助內容

1. 博士修業期間每年獎助新台幣 50 萬元整，至多獎助五年。
2. 由台積電資深主管擔任業師，協助了解產業、技術發展階段與挑戰。
3. 在學期間提供台積電實習機會。

三、申請資格

1. 具中華民國國籍且預計於 2025 年攻讀國內大學半導體相關科系博士學位(含申請中)之學、碩士班學生，規劃從事半導體相關領域研究(如下)，並經指導教授推薦申請者。
2. 研究領域
 - (1) Semiconductor devices and memories development, electrical characterization methodology & physics, and TCAD.
 - (2) Semiconductor processes, material science, equipment/tools, and machine learning and AI for modeling - plasma physics, surface chemistry reaction, selective deposition on dielectric/conductor, electro-chemistry, atomic-layer deposition/etch, organic/in-organic chemistry synthesis, physical chemistry, lithography, e-beam, chemical vapor deposition, physical vapor deposition, and vacuum system.
 - (3) Exotic devices and materials - spintronics, magnetism, two-dimensional (2D) materials.
 - (4) Compact modeling about semiconductor electrical/magnetic devices, interconnection, radio-frequency mmWave, three-dimensional IC (3DIC), microelectromechanical system (MEMS) and bio-sensor.
 - (5) Algorithm development for model extraction/characterization or methodology for new applications of SPICE simulation.
 - (6) First-principles modeling of material characteristics (electrical, magnetics, etc.), material design and synthesis for nano-scale fabrication.
 - (7) Electronic design automation (EDA) and methodology, focusing on tool/methodology for future design-technology co-optimization (DTCO).
 - (8) Next-generation design architectures, including three-dimensional IC (3DIC), power distribution network, standard cells, memory, input/output (IO), etc.
 - (9) 3DIC/advanced packaging-related (Develop the best PPAC interconnect and packaging integration technology to integrate different semiconductor elements as one system)
 - (10) Other semiconductor-related topics.

四、申請方式

1. 時程：即日起至 2024 年 10 月 30 日(含)止，並以完整提交申請相關文件之日期為憑。
2. 方式：請備妥下列文件電子檔案，以電子郵件寄至「台灣積體電路製造股份有限公司 人才開發暨招募處」高小姐 (E-Mail: chenkw@tsmc.com)。
 - (1) 獎學金申請表
 - (2) 個人完整履歷表
 - (3) 歷年學業成績單
 - (4) 博士學位研究計畫書
 - (5) 個人資料蒐集、處理及利用同意書
 - (6) 教授推薦信 (第一階段審查加分項，最晚須於第二階段審查前提供)
 - (7) 英文檢定證明 (第一階段審查加分項)
 - (8) 碩士論文成果 / 專題研究成果 (第一階段審查加分項)
 - (9) 課外活動或服務歷程/成果 (第一階段審查加分項)

未依申請規定填寫申請文件、申請文件不全或逾期未完成申請作業者，恕不受理。

五、遴選程序

1. 第一階段書面審查：由台積電博士獎學金遴選委員會共同審查申請者繳交之相關文件，預計於 2024 年 12 月 13 日公告第一階段審查結果。
2. 第二階段面試簡報：通過第一階段審查者，將由台積電邀約至公司面試，未能親臨面試者，視同放棄。
3. 結果公告：2025 年 1 月 31 日
4. 授獎活動：2025 年 10 月 (確切日期另行通知)

六、履行義務

1. 獲獎學生於獎助期間須維持全職學生身分，並不得同時領取其他企業相似性質之獎學金，包括且不限於：企業提供赴外研修之獎助學金、企業提供薪資供學生於該企業或其他合作之學研機構從事研究之獎助學金等。若獲獎學生對於所受領之獎學金是否屬本條所稱「其他其企業相似性質之獎學金」有疑慮時，應於申請該他種獎學金或申請本獎學金前，事先向台積電招募部確認。違反本條約定者，台積電有權取消該名學生獲獎資格，終止其受領本獎學金之資格。由政府機關及非營利性質財團法人捐助用於學術合作性質之獎助學金不在此限。
2. 獲獎學生研究領域須限於本辦法第三條第二項所列之半導體相關領域。獲獎學生於獲獎後，應先與指導教授與台積電業師確認其研究題目與半導體領域相關，始具受領本獎學金資格。於獎助期間，如經台積電業師審核，該獲獎學生之研究已偏向非半導體相關之領域，經台積電業師建議其轉回研究半導體相關之領域後未果，台積電有權取消該名學生獲獎資格，終止其受領本獎學金之資格。
3. 獲獎學生需於入學兩年內完成博士資格考，並由指導教授與台積電業師提供年度審核結果；未通過資格考或年度審核者，由遴選委員決定是否繼續提供獎學金。



七、 聯繫窗口

台灣積體電路製造股份有限公司 人才開發暨招募處 高小姐

Tel: (03)563-6688 #752-3580/ E-Mail: chenkw@tsmc.com

附件一

台積電博士獎學金申請表 (2025 年第一梯次)

一、申請人基本資料 (以下僅供獎學金相關事宜之聯絡使用，不做其他用途)

| | | | |
|----------|--|-------------|-------|
| 姓名 | | 性別 | |
| 類別 | <input type="checkbox"/> 學逕博 <input type="checkbox"/> 碩逕博(<input type="checkbox"/> 碩一上、 <input type="checkbox"/> 碩一下、 <input type="checkbox"/> 碩二上、 <input type="checkbox"/> 碩二下) | | |
| 碩士 | 學校 | | 科系/主修 |
| 學士 | 學校 | | 科系/主修 |
| 聯絡電話 | | | |
| Email | | | |
| 推薦(指導)教授 | | 教授 Email | |

二、規劃申請學校列表：(請填寫申請中的博士班學校/科系資訊)

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 學校 | | | |
| 科系 | | 入學 | <input type="checkbox"/> 114 年 2 月 <input type="checkbox"/> 114 年 9 月 |
| 研究主題關鍵字 | | | |
| (預計)指導教授 | | | |

三、請勾選修習過之半導體相關課程

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> 電子學 <input type="checkbox"/> 電路學 <input type="checkbox"/> 半導體元件物理 <input type="checkbox"/> 半導體(積體電路)製程技術 <input type="checkbox"/> 積體電路設計 <input type="checkbox"/> 數位電路設計 <input type="checkbox"/> 類比電路設計 <input type="checkbox"/> 電子材料/材料分析 <input type="checkbox"/> 薄膜製程 <input type="checkbox"/> 固態熱力學 <input type="checkbox"/> 近代物理 <input type="checkbox"/> 固態物理 <input type="checkbox"/> 分析化學 <input type="checkbox"/> 材料化學 <input type="checkbox"/> 電化學 |
|--|

其中，印象最深的是哪一門課？(300 字以內)

四、請簡述擬研究領域/主題與「半導體產業」之關聯性。(300字以內)

| |
|--|
| |
|--|

五、請列出在學成績(GPA)、英文檢定成績、曾獲獎項與特殊榮譽。

| | |
|---|---|
| 是否參與過台積聯合研發計畫？ | |
| <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是；計畫名稱： | |
| GPA | 英文檢定成績 |
| <input type="checkbox"/> 大學： <input type="checkbox"/> 碩士： | <input type="checkbox"/> 檢定名稱： <input type="checkbox"/> 成績： |
| 其他獎項或特殊榮譽(扼要條列)： | |
| | |

六、請確認是否已備妥以下資料：

- 獎學金申請表
- 個人完整履歷表
- 歷年學業成績單
- 博士學位研究計畫書
- 個人資料蒐集、處理及利用同意書
- 教授推薦信 (第一階段審查加分項，最晚須於第二階段審查前提供)
- 英文檢定證明 (第一階段審查加分項)
- 碩士論文成果 / 專題研究成果 (第一階段審查加分項)
- 課外活動或服務歷程/成果 (第一階段審查加分項)

確認無誤後，請將上述備審資料/文件之電子檔，透過電子郵件寄至

「台灣積體電路製造股份有限公司 人才開發暨招募部」高小姐 (E-Mail: chenkw@tsmc.com)。

若有任何問題，歡迎來電詢問 (03)563-6688 #752-3580。

附件二

台積電博士獎學金 個人資料蒐集、處理及利用同意書

您為申請台積電博士獎學金(下稱「本獎學金」)，將提供台灣積體電路股份有限公司(下稱「台積電」或「本公司」)個人資料，為保障您的權益，本公司謹依個人資料保護法第八條第一項，告知您以下事項。若您於後勾選同意並簽署本同意書，即代表您已充分瞭解本同意書之內容並同意受其拘束：

一、個人資料蒐集之目的

本公司為處理您報名本獎學金相關事宜(包括且不限為報名管理、身分確認、審核活動聯繫等)，並將您的資料建檔於本公司人才資料庫等目的，將蒐集、處理、利用您的個人資料。依據法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之分類，上述本公司蒐集您個人資料之目的屬「人事管理(002)」、「契約、類似契約或其他法律關係事務(069)」、「教育或訓練行政(109)」、「產學合作(110)」、「其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(181)」等。

二、個人資料之類別

本公司僅會於本同意書第一條所定特定目的範圍內，蒐集您的個人資料。這些資料包括但不限於您的姓名、身分證字號、學校、電子信箱等可以辨識您本人之資料。依據法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之分類，本公司蒐集您的個人資料之類別包括「辨識個人者(C001)」、「政府資料中之辨識者(C003)」、「個人描述(C011)」、「學校記錄(C051)」、「資格或技術(C052)」、「著作(C056)」、「學生(員)、應考人紀錄(C057)」、「工作經驗(C064)」等。

三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式

1. 本公司將於第一條特定目的範圍內，以電子郵件或其他方式，在中華民國境內或境外蒐集、處理、利用您的個人資料。為達成第一條所列之目的，本公司得傳輸您之個人資料予本公司之從屬/控制公司(依公司法第369條之2之規定)，及伺服器提供者等受本公司委託處理您個人資料之第三人。
2. 本公司將於本公司經營期間，且本同意書第一條目的尚存續時，利用及處理您的個人資料。

四、您依個人資料保護法所得行使之權利及方式

1. 就您提供予本公司之個人資料，您有權向本公司：(1)查詢或請求閱覽；(2)請求製給複製本；(3)請求補充或更正；(4)請求停止蒐集、處理或利用；(5)請求刪除的權利。
2. 您依本條第1項約定提出請求時，須檢附相關證明文件向本公司提出書面請求；就您查詢或請求閱覽個人資料或製給複製本時，本公司得酌收必要成本費用。您瞭解，若您要求本公司刪除、停止繼續使用您的個人資料，將可能影響您申請及受領本獎學金之資格。

五、不提供個人資料對您權益之影響

您可以自由決定是否提供您的個人資料予本公司，惟您亦瞭解如不完整提供該等資料，您將無法申請本獎學金。

我同意並瞭解上述台積電博士獎學金個人資料蒐集、處理及利用同意書所有內容，並擔保我所提供予台積電之資料均屬真實正確。

聲 明 人：_____

身分證字號：_____

通 訊 地 址：_____